

	<p>SI8819EDB-T2-E1</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI8819EDB-T2-E1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 2.9A 4-MICROFOOT</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI8819EDB-T2-E1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


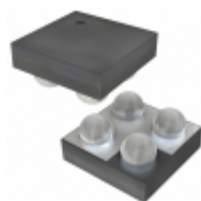






Spezifikationen

Teilenummer	SI8819EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 2.9A 4-MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-MICRO FOOT® (0.8x0.8)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 1.5A, 3.7V
Verlustleistung (max)	900mW (Ta)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 3.7V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 2.9A (Ta) 900mW (Ta) Surface Mount 4-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Ta)

SI8819EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8819EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8819EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8819EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI88220BC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8821EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V MICRO FOOT</p>	 <p>SI88220BC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI88220EC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p>SI8812DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8816EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>	 <p>SI8817DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8816EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8819EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / SI8819EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8819EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8819EDB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI8819EDB-T2-E1 Vishay	SI8819EDB-T2-E1-Komponenten	SI8819EDB-T2-E1-Verteiler	SI8819EDB-T2-E1
SI8819EDB-T2-E1 Electronic	SI8819EDB-T2-E1 Hersteller	SI8819EDB-T2-E1 Bild	SI8819EDB-T2-E1-Teil
SI8819EDB-T2-E1 Preis	SI8819EDB-T2-E1 Original	SI8819EDB-T2-E1 garantiert	SI8819EDB-T2-E1 Inventar
SI8819EDB-T2-E1 Neu	SI8819EDB-T2-E1 Original	SI8819EDB-T2-E1 garantiert	SI8819EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited